Fig.3 Raman spectrum of HsGDY

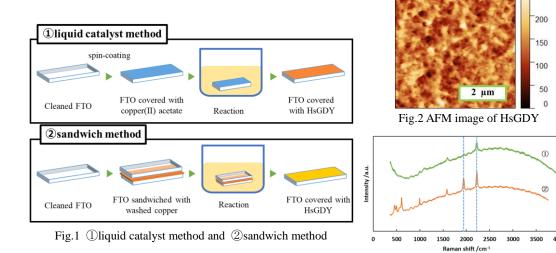
フッ素ドープ酸化スズ上への水素置換グラフィジインの合成

Synthesis of hydrogen substituted graphdiyne onto fluorine-doped tin oxide substrates 豊田工大工 ^O(M2)山本 輝, (P) Jeganathan Chellamuthu,原 正則,吉村 雅満 Graduate School of Engineering, Toyota Technological Institute

°Hikaru Yamamoto, Jeganathan Chellamuthu, Masanori Hara, Masamichi Yoshimura E-mail: sd23444@toyota-ti.ac.jp

近年、持続開発社会の実現に向けて、高性能太陽電池の開発や実用化が進められている。簡便に作製でき、意匠性のある色素増感太陽電池(DSSC)は、シリコン系太陽電池(>26%[1])と比較してエネルギー変換効率(PCE)が低い。高い伝導率[2]と多くの細孔構造を持つ水素置換グラフィジイン(HsGDY)は DSSC の PCE を向上させる対極材料として期待されている。これまでに、Cu^[3]などの金属基板上への合成法の報告はあるが、DSSC への応用のためには、透明なフッ素ドープ酸化スズ(FTO)上への合成を行う必要がある。本報告では、①液体触媒法と②挟み込み法により HsGDY の合成を試みたので報告する。

①では copper(II) acetate と polyvinylpyrrolidone 水溶液を FTO 基板上にスピンコートし、②では 2 つの FTO 基板間に、ethanol, acetone, HCI で 10 分ずつ洗浄した Cu 基板を挟み込む(Fig.1)。次に、1,3,5-Triethynylbenzene、pyridine、piperidine の混合溶液に 60℃で 1 日浸して合成した。原子間力顕微鏡(AFM)から、両者とも HsGDY 特有のネットワーク構造が観察され(Fig.2)、Raman 分光法から、1935 cm⁻¹、および、2225 cm⁻¹付近に-C≡C-由来のピークが確認でき(Fig.3)、両手法とも HsGDY 合成が可能であることがわかった。



参考文献:

- [1] W. Cui et al., Materials Today Nano, 22, 100329 (2023).
- [2] J. Li et al., Advanced Functional Materials, **31**, 2100994 (2021).
- [3] J. He et al., Nature Communications, **8**, 1172 (2017).